CURRÍCULUM VÍTAE NORMALIZADO

José Manuel García Tijero

Generado desde: Editor CVN de FECYT

Fecha del documento: 18/10/2023

v 1.4.3

521068a0bdae608bcd9b3aff658c43fa

Este fichero electrónico (PDF) contiene incrustada la tecnología CVN (CVN-XML). La tecnología CVN de este fichero permite exportar e importar los datos curriculares desde y hacia cualquier base de datos compatible. Listado de Bases de Datos adaptadas disponible en http://cvn.fecyt.es/

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

FECYT INNOVACIÓN

Resumen libre del currículum

Descripción breve de la trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos obtenidos, los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de la línea de investigación. Incluye también otros aspectos o peculiaridades importantes.

sexenios de investigación. 58 publicaciones en revistas JCR (48:Q1-Q2). 2 capítulos de libro. Índice h en WoS: 16. 5 proyectos nacionales dirigidos.

José Manuel García Tijero

Apellidos:	**García Tijero**
Nombre:	**José Manuel**
ORCID:	**0000-0002-7414-8855**
ScopusID:	**7004351174**
ResearcherID:	**O-2673-2017**
Sexo:	**Hombre**
Nacionalidad:	**España**
Provincia de contacto:	**Madrid**
Dirección de contacto:	**CEMDATIC. ETSI de Telecomunicacion. UPM**
Resto de dirección contacto:	**Ave. Complutense s/n.**
Código postal:	**28040**
País de contacto:	**España**
C. Autón./Reg. de contacto:	**Comunidad de Madrid**
Ciudad de contacto:	**Madrid.**
Teléfono fijo:	**(0034) 910672484**
Correo electrónico:	**jm.g.tijero@upm.es**

Situación profesional actual

Entidad empleadora: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Departamento: DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS Y FÍSICA DE EDIFICACIÓN, Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Categoría profesional: Catedrático de Universidad
Ciudad entidad empleadora: MADRID, Comunidad de Madrid, España
Teléfono: (0034) 91 0672484 **Correo electrónico:** jm.g.tijero@upm.es
Fecha de inicio: 21/03/2023
Modalidad de contrato: Funcionario/a **Régimen de dedicación:** Tiempo completo
Primaria (Cód. Unesco): 221124 - Propiedades ópticas; 330714 - Dispositivos semiconductores
Secundaria (Cód. Unesco): 221125 - Semiconductores; 330707 - Dispositivos láser; 330714 - Dispositivos semiconductores
Identificar palabras clave: Materiales ópticos; Semiconductores

Cargos y actividades desempeñados con anterioridad

	Entidad empleadora	Categoría profesional	Fecha de inicio
1	Universidad Politécnica de Madrid	Profesor Titular de Universidad	14/11/1996
2	Universidad Politécnica de Madrid	Profesor Titular Interino	15/06/1993
3	University of California, Los Angeles	Visiting scholar	01/01/1991
4	Universidad Autónoma de Madrid	Profesor Asociado	31/03/1990
5	Universidad Autónoma de Madrid	Ayudante LRU	01/10/1988

1 **Entidad empleadora:** Universidad Politécnica de Madrid
Categoría profesional: Profesor Titular de Universidad
Fecha de inicio-fin: 14/11/1996 - 21/03/2023 **Duración:** 26 años

2 **Entidad empleadora:** Universidad Politécnica de Madrid
Categoría profesional: Profesor Titular Interino
Fecha de inicio-fin: 15/06/1993 - 13/11/1996

3 **Entidad empleadora:** University of California, Los Angeles **Tipo de entidad:** Universidad
Categoría profesional: Visiting scholar
Fecha de inicio-fin: 01/01/1991 - 31/12/1992 **Duración:** 2 años

4 **Entidad empleadora:** Universidad Autónoma de Madrid
Categoría profesional: Profesor Asociado
Fecha de inicio-fin: 31/03/1990 - 30/09/1990 **Duración:** 6 meses

5 **Entidad empleadora:** Universidad Autónoma de Madrid
Categoría profesional: Ayudante LRU
Fecha de inicio-fin: 01/10/1988 - 30/09/1989

Formación académica recibida

Titulación universitaria

Estudios de 1º y 2º ciclo, y antiguos ciclos (Licenciados, Diplomados, Ingenieros Superiores, Ingenieros Técnicos, Arquitectos)

Nombre del título: Licenciado en Ciencias Físicas
Entidad de titulación: Universidad de Zaragoza
Fecha de titulación: 25/10/1984

Doctorados

Programa de doctorado: Doctorado en Ciencias Físicas
Entidad de titulación: Universidad Autónoma de Madrid
Fecha de titulación: 06/07/1989

Actividad docente

Formación académica impartida

1 Tipo de docencia: Docencia oficial
Nombre de la asignatura/curso: Física de las Construcciones
Tipo de programa: Arquitectura
Tipo de docencia: Teórica presencial
Tipo de asignatura: Troncal
Titulación universitaria: Graduado o Graduada en Fundamentos de Arquitectura
Curso que se imparte: 2
Frecuencia de la actividad: 6,5
Fecha de inicio: 01/02/2012
Fecha de finalización: 26/05/2023
Tipo de horas/créditos ECTS: Créditos
Nº de horas/créditos ECTS: 6
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid
Tipo de entidad: Universidad
Facultad, instituto, centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Departamento: Estrucuras y Física de la Edificación

2 Tipo de docencia: Docencia oficial
Nombre de la asignatura/curso: Photonics Technologies II
Tipo de programa: Máster oficial
Tipo de docencia: Teórica presencial
Tipo de asignatura: Obligatoria
Titulación universitaria: Master Universitario en Ingeniería Fotónica
Frecuencia de la actividad: 6
Fecha de inicio: 15/09/2017
Fecha de finalización: 22/12/2022
Tipo de horas/créditos ECTS: Horas

Nº de horas/créditos ECTS: 12
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Facultad, instituto, centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
Idioma de la asignatura: Inglés

3 Tipo de docencia: Docencia oficial
Nombre de la asignatura/curso: Mecánica Física
Tipo de programa: Arquitectura **Tipo de docencia:** Teórica presencial
Tipo de asignatura: Troncal
Titulación universitaria: Graduado o Graduada en Fundamentos de Arquitectura
Curso que se imparte: 2 **Frecuencia de la actividad:** 12
Fecha de inicio: 06/09/2011 **Fecha de finalización:** 22/12/2022
Tipo de horas/créditos ECTS: Créditos
Nº de horas/créditos ECTS: 6
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Facultad, instituto, centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Departamento: Estrucuras y Física de la Edificación

4 Tipo de docencia: Docencia oficial
Nombre de la asignatura/curso: Fundamentos y Teorías Físicas
Tipo de programa: Arquitectura **Tipo de docencia:** Teórica presencial
Tipo de asignatura: Troncal
Titulación universitaria: Arquitecto
Curso que se imparte: 1 **Frecuencia de la actividad:** 21
Fecha de inicio: 03/02/1997 **Fecha de finalización:** 20/12/2010
Tipo de horas/créditos ECTS: Horas
Nº de horas/créditos ECTS: 100
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Facultad, instituto, centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Departamento: Física e instalaciones Aplicadas

5 Tipo de docencia: Docencia oficial
Nombre de la asignatura/curso: Física
Tipo de programa: Arquitectura **Tipo de docencia:** Teórica presencial
Tipo de asignatura: Troncal
Titulación universitaria: Arquitecto
Curso que se imparte: 2 **Frecuencia de la actividad:** 3,5
Fecha de inicio: 01/10/1993 **Fecha de finalización:** 30/05/1997
Tipo de horas/créditos ECTS: Horas
Nº de horas/créditos ECTS: 140
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Facultad, instituto, centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Departamento: Física e Instalaciones Aplicadas

6 Nombre de la asignatura/curso: Física General
Titulación universitaria: Licenciado en Ciencias Biológicas
Fecha de inicio: 31/03/1990 **Fecha de finalización:** 30/09/1990

Entidad de realización: Universidad Autónoma de Madrid
Tipo de entidad: Universidad
Facultad, instituto, centro: Ciencias

7 Nombre de la asignatura/curso: Laboratorio Física General
Titulación universitaria: Licenciado en Ciencias Físicas
Fecha de inicio: 01/10/1988
Fecha de finalización: 30/09/1989
Entidad de realización: Universidad Autónoma de Madrid
Tipo de entidad: Universidad
Facultad, instituto, centro: Ciencias

Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera

1 Título del trabajo: Ranging systems based on semiconductor lasers using pseudorandom modulation and dual frequency combs
Tipo de proyecto: Trabajo fin de Master
Entidad de realización: Universidad Carlos III de Madrid
Tipo de entidad: Universidad
Alumno/a: Elena Sentre Arribas
Fecha de defensa: 14/07/2021

2 Título del trabajo: Experimental and Theoretical Study of the Optical Frequency Combs generated by Gain-Switching of Semiconductor Lasers
Tipo de proyecto: Tesis Doctoral
Codirector/a tesis: José Manuel García Tijero; Ignacio Esquivias Moscardó
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid
Tipo de entidad: Universidad
Alumno/a: Alejandro Rosado Pérez
Calificación obtenida: Sobresaliente cum Laude
Fecha de defensa: 29/01/2020
Doctorado Europeo: No
Mención de calidad: No

3 Título del trabajo: Emission characteristics of 1.5 µm monolithically integrated master-oscillator power-amplifiers
Tipo de proyecto: Tesis Doctoral
Codirector/a tesis: José Manuel García Tijero; Ignacio Esquivias Moscardó
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid
Tipo de entidad: Universidad
Alumno/a: Mariafernanda Vilera Suarez
Calificación obtenida: Sobresaliente cum Laude
Fecha de defensa: 31/01/2017

Experiencia científica y tecnológica

Actividad científica o tecnológica

Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas

1 Nombre del proyecto: Photonic Integrated Circuits for Gas Sensing, Ranging, and Quantum Random Number Generation (PICSAR)
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Ignacio Esquivias Moscardó/Antonio Pérez Serrano
Entidad/es financiadora/s:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref: PID2021-123459OB-C21

Fecha de inicio-fin: 01/09/2022 - 31/08/2025
Entidad/es participante/s: Proyecto coordinado: Universidad Politécnica de Madrid (coordinador) y Universidad de Cantabria
Cuantía total: 175.450 €

2 Nombre del proyecto: Sensado remoto de emisiones contaminantes con espectroscopía de peines duales basados en diodos laser conmutados en ganancia de bajo coste
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): José Manuel García Tijero/Ignacio Esquivias Moscardó
Entidad/es financiadora/s:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref:TED2021-131957B-I00

Fecha de inicio-fin: 01/12/2022 - 30/11/2024
Cuantía total: 151.570 €

3 Nombre del proyecto: Sensores y sistemas de instrumentación basados en tecnologías fotónicas 2 (SINFOTON2-CM) (Programa de Actividades de I+D para consorcios de Grupos de Investigación de la Comunidad de Madrid
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): (UPM): Xabier Quintana Arregui
Entidad/es financiadora/s:
Comunidad Autónoma de Madrid. Ref.: P2018/NMT-4326

Fecha de inicio-fin: 01/01/2019 - 31/12/2022
Entidad/es participante/s: Instituto de Óptica Daza de Valdés; Proyecto coordinado: Universidad Carlos III de Madrid (coordinador); U. Politécnica de Madrid; U. de Alcalá de Henares; Universidad Rey Juan Carlos
Cuantía total: 1.066.260 €

4 Nombre del proyecto: Sistemas Lidar Avanzados Basados en Peines de Frecuencia Opticos, Tecnologias Coherentes y Señales Caoticas (LIDERA)
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): José Manuel García Tijero/Ignacio Esquivias Moscardó _
Entidad/es financiadora/s:
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Ref: RTI2018-094118-B-C21

Fecha de inicio-fin: 01/01/2019 - 30/06/2022
Entidad/es participante/s: Proyecto coordinado: Universidad Politécnica de Madrid (coordinador) y Universidad de Cantabria
Cuantía total: 199.408 €

5 Nombre del proyecto: Peines de frecuencia generados por láseres de semiconductor (COMBINA)
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): José Manuel García Tijero
Entidad/es financiadora/s:
Ministerio de Economia y Competitividad. Ref.: TEC2015-65212-C3-2-P

Fecha de inicio-fin: 01/01/2016 - 31/12/2018
Entidad/es participante/s: Proyecto coordinado: Universidad de Cantabria (coordinador); Universidad Politécnica de Madrid; Universidad de las Islas Baleares
Cuantía total: 118.217 €

6 Nombre del proyecto: Sensores y sistemas de instrumentación basados en tecnologías fotónicas (SINFOTON-CM) (Programa de Actividades de I+D para consorcios de Grupos de Investigación de la Comunidad de Madrid)
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): (UPM): José Manuel Otón Sánchez
Entidad/es financiadora/s:
Comunidad Autónoma de Madrid. Ref.: S2013/MIT-2790

Fecha de inicio-fin: 01/10/2014 - 30/09/2018
Entidad/es participante/s: Instituto de Óptica Daza de Valdés; Proyecto coordinado: Universidad Carlos III de Madrid (coordinador); U. Politécnica de Madrid; U. de Alcalá de Henares; Universidad Rey Juan Carlos

7 Nombre del proyecto: Optical Switch for Space Applications with no Moving Parts
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): (UPM): José Manuel García Tijero
Entidad/es financiadora/s:
Agencia Espacial Europea (ESA) (ITT AO/1-8427/15NL/RA/ZK)

Fecha de inicio-fin: 01/04/2016 - 31/03/2018 **Duración:** 2 años
Entidad/es participante/s: Alter Technology TUV Nord S.A.U.; Universidad Politécnica de Madrid (como subcontratado de Alter Technology)
Cuantía total: 30.000 €

8 Nombre del proyecto: Técnicas de Medición de Distancias Usando Láseres de Semiconductor Avanzados (RANGER)
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): José Manuel García Tijero
Entidad/es financiadora/s:
Ministerio de Economia y Competitividad. Ref.: TEC2012-38864-C03-02

Fecha de inicio-fin: 01/01/2013 - 31/12/2015
Entidad/es participante/s: Proyecto coordinado: Universidad de las Islas Baleares (coordinador); Universidad Politécnica de Madrid; Universidad de Cantabria
Cuantía total: 157.599 €

9 **Nombre del proyecto:** High Brightness Semiconductor Laser Sources for Space Applications in Earth Observation (BRITESPACE)
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): IGNACIO ESQUIVIAS MOSCARDÓ
Entidad/es financiadora/s:
European Commission, 7th Frameprogramm, FP7-SPACE-2012-1, STREP (6 socios). Ref. 313200

Fecha de inicio-fin: 01/12/2012 - 30/11/2015
Entidad/es participante/s: Alter Technology TUV Nord S.A.U. (España); Deutsches Zentrums für Luft- und Raumfahrt (Alemania); Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT (Alemania); III-V Lab GIE (Francia); Universidad Politécnica de Madrid (coordinador); University of Bristol (Reino Unido)
Cuantía total: 300.951 €

10 **Nombre del proyecto:** Multi-Gigahertz Optical Modulator of Very Low Driving Power
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Ignacio Esquivias
Entidad/es financiadora/s:
Agencia Espacial Europea (ESA) (ESA-2005 ITT 4862)

Fecha de inicio-fin: 09/2006 - 04/2014
Entidad/es participante/s: Alcatel Alenia (Fr); Photline Technologies (Fr); Tecnológica S.L. (España); U. Politécnica de Madrid
Cuantía total: 24.400 €

11 **Nombre del proyecto:** FACTOTEM2: Fotónica Aplicada para la Creación de Tecnologías Ópticas y su Transferencia a Empresas Madrileñas (Programa de Actividades de I+D para consorcios de Grupos de Investigación de la Comunidad de Madrid)
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): J.M. OTÓN SÁNCHEZ
Entidad/es financiadora/s:
Comunidad de Madrid. Ref: S2009/ESP-1781

Fecha de inicio-fin: 01/01/2010 -31/12/2013
Entidad/es participante/s: FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES; Instituto de Física Aplicada; Universidad Carlos III de Madrid; Universidad Politécnica de Madrid; Universidad Rey Juan Carlos
Cuantía total: 1.046.095 €

12 **Nombre del proyecto:** Laseres de Semiconductor Avanzados para Procesado de Señal Todo-Optico y Generacion de Pulsos Cortos (ALAS)
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Ignacio Esquivias Moscardó

Entidad/es financiadora/s:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref.: TEC2009-14581-C02-01. Proyecto Coordinado

Fecha de inicio-fin: 01/01/2010 - 31/12/2012
Entidad/es participante/s: Universidad Politécnica de Madrid (Coordinador); Universidad de Cantabria
Cuantía total: 144.000 €

13 **Nombre del proyecto:** Screening and pre-evaluation of shortwave infrared laser diode for space application
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Ignacio Esquivias
Entidad/es financiadora/s:
Agencia Espacial Europea (ESA) (ESA-2008 ITT 5618)

Fecha de inicio-fin: 12/2008 - 31/03/2011
Entidad/es participante/s: Alter Technology Group Spain; Nanoplus (Alemania); Universidad Politécnica de Madrid
Cuantía total: 12.000 €

14 **Nombre del proyecto:** FACTOTEM-CM: Fotónica Aplicada para la Creación de Tecnologías Ópticas y su Transferencia a Empresas Madrileñas (Programa de Actividades de I+D para consorcios de Grupos de Investigación de la Comunidad de Madrid)
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): J.M. OTÓN SÁNCHEZ (Coordinador)
Entidad/es financiadora/s:
Comunidad de Madrid. Ref: S-0505/ESP/0417

Fecha de inicio-fin: 01/01/2006 - 31/12/2009
Entidad/es participante/s: Instituto de Física Aplicada (CSIC); Universidad Carlos III de Madrid; Universidad Politécnica de Madrid; Universidad Rey Juan Carlos
Cuantía total: 539.520 €

15 **Nombre del proyecto:** Desarrollo de Técnicas de Banda-Ultra-Ancha Mediante Pulsos Generados por Diodos Láser: Aplicaciones a las Comunicaciones Ópticas Inalámbricas (BLANCO)
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Francisco Jose López Hernández
Entidad/es financiadora/s:
Ministerio de Educación y Ciencia. Ref.: TEC2006-13887-C05-01/TCM. Proyecto Coordinado

Fecha de inicio-fin: 01/10/2006 - 30/09/2009
Entidad/es participante/s: Instituto Mediterraneo de Estudios Avanzados (CSIC); Universidad Politécnica de Madrid; Universidad de Cantabria; Universidad de La Laguna
Cuantía total: 95.500 €

16 **Nombre del proyecto:** WWW.BRIGHTER.EU: : Word Wide Welfare: High Brightness Semiconductor Lasers for Generic Use.
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): IGNACIO ESQUIVIAS MOSCARDÓ
Entidad/es financiadora/s:
Comisión Europea. 6º Programa Marco. Ref.: IST-2005-035266

Fecha de inicio-fin: 01/10/2006 - 30/09/2009

Entidad/es participante/s: Alcatel Thales III V Lab (Francia) (coordinador); Alcatel-CIT (Francia); Biolitec AG (Alemania); FBH Forschungsverbund Berlin (Alemania); Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V. (FHG) (Alemania); Hasta un total de 25; High Pressure Research Center, Polish Academy of Sciences (UNIPRESS) (Polonia); OSRAM Opto Semiconductors GmbH (Alemania); Thales (Francia); Universidad Politécnica de Madrid; University of Cambridge (Reino Unido)
Cuantía total: 217.850 €

17 **Nombre del proyecto:** High Efficiency Optical Amplifier for On-Board Fiber Optic Subsystems Applications
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): F.J. López Hernández
Entidad/es financiadora/s:
Agencia Espacial Europea (ESA) (ESA-2005 ITT 4849)

Fecha de inicio-fin: 06/2006 - 06/2009
Entidad/es participante/s: Alcatel Alenia (Fr); Tecnológica S.L.; U. Politécnica de Madrid
Cuantía total: 12.000 €

18 **Nombre del proyecto:** Láseres de Semiconductor de Alto Brillo para Uso Genérico (Acción Complementaria de preparación de Proyecto Europeo)
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): IGNACIO ESQUIVIAS MOSCARDÓ
Entidad/es financiadora/s:
Ministerio de Educación y Ciencia. Ref. TEC2006-27627-E

Fecha de inicio-fin: 01/01/2007 - 01/01/2008
Cuantía total: 1.220 €

19 **Nombre del proyecto:** Ayuda Complementaria al proyecto Láseres de Semiconductor de Alto Brillo para Uso Genérico
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Ignacio Esquivias Moscardó
Entidad/es financiadora/s:
Ministerio de Educación y Ciencia. Ref. TEC2007-29619-E **Tipo de entidad:** Agencia Estatal

Fecha de inicio-fin: 01/10/2006 - 31/12/2007
Cuantía total: 9.600 €

20 **Nombre del proyecto:** Diodos Láser de Alto Brillo para Aplicaciones en Telecomunicación, Medicina y Medio Ambiente (Acción Complementaria a Proyecto Europeo)
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): IGNACIO ESQUIVIAS MOSCARDÓ
Entidad/es financiadora/s:
Ministerio de Educación y Ciencia. Ref.: TEC2004-22765-E

Fecha de inicio-fin: 01/07/2004 - 30/06/2006
Cuantía total: 2.950 €

21 **Nombre del proyecto:** Wide Wavelength light for public Welfare: High-Brightness Laser Diode Systems for Health, Telecom and Environment Use (WWW.BRIGHT.EU)
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): IGNACIO ESQUIVIAS MOSCARDÓ
Entidad/es financiadora/s:
Comisión Europea. PF 6. Ref.: 511722

Fecha de inicio-fin: 01/07/2004 - 30/06/2006
Entidad/es participante/s: Alcatel-CIT (Francia); Biolitec AG (Alemania); Hasta 21 participantes; OSRAM Opto Semiconductors GmbH (Alemania); Thales Laser Diodes (Francia); Thales Research & Technology (TRT) (Francia); Universidad Politécnica de Madrid; University of Cambridge (Reino Unido)
Cuantía total: 93.105 €

22 **Nombre del proyecto:** Diodos Láser de Alto Brillo para Aplicaciones en Telecomunicación, Medicina y Medio Ambiente (Acción Complementaria de preparación de Proyecto Europeo)
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): IGNACIO ESQUIVIAS MOSCARDÓ
Entidad/es financiadora/s:
Ministerio de Educación y Ciencia. Ref.: TEC2004-22800-E

Fecha de inicio-fin: 01/07/2003 - 31/12/2005
Cuantía total: 1.730 €

23 **Nombre del proyecto:** GaInNAs-based semiconductor heterostructures for 1.5 m opto-electronics (GINA)
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Jose Manuel García Tijero (desde Junio 2001 hasta Abril 2002)
Entidad/es financiadora/s:
Unión Europea. ESPRIT IST-2000-26478

Fecha de inicio-fin: 01/06/2001 - 31/05/2004

24 **Nombre del proyecto:** Detectores de IR de heteroestructuras cuánticas sobre GaAs (Proyecto coordinado)
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Jose Manuel García Tijero (hasta abril 2002)
Entidad/es financiadora/s:
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ref.: TIC2000-0380-C03-02

Fecha de inicio-fin: 28/12/2000 - 27/12/2003
Entidad/es participante/s: Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA); Universidad Politécnica de Madrid; Universidad de Alcalá de Henares
Cuantía total: 100.970 €

25 **Nombre del proyecto:** Detectores de IR basados en Pozos y Puntos Cuánticos de InGaAs/Ga (Acción Integrada Hispano Británica)
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Jose Manuel García Tijero
Entidad/es financiadora/s:
Ministerio de Educación y Ciencia. Acción Integrada, HB199-0028

Fecha de inicio-fin: 01/04/2000 - 31/03/2002
Entidad/es participante/s: Universidad Politécnica de Madrid (Coordinador); University of Sheffield
Cuantía total: 6.840 €

26 **Nombre del proyecto:** Láseres sintonizables en la banda 1-1.3 micras sobre sustratos de GaAs (111)B
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Ignacio Izpura
Entidad/es financiadora/s:
Ministerio de Educación y Cultura. TIC98-0826-C02-01

Fecha de inicio-fin: 01/12/1998 - 30/11/2001
Entidad/es participante/s: Universidad Politécnica de Madrid (Coordinador); Universidad de Cádiz
Cuantía total: 41.400 €

27 **Nombre del proyecto:** GaAs High Index Substrates for Optoelectronics (GHISO)
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Ignacio Izpura Torres
Entidad/es financiadora/s:
Comisión Europea. RTD ESPRIT 25112

Fecha de inicio-fin: 01/01/1999 - 31/12/2000
Entidad/es participante/s: CNRS-LAAS Toulouse; Thomson-LCR; Universidad Politécnica de Madrid (Coordinador); University of Sheffield
Cuantía total: 240.000 €

28 **Nombre del proyecto:** Detectores de infrarrojo basados en superredes con heterouniones III-V
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): José Luis Sánchez Rojas
Entidad/es financiadora/s:
CICYT. TIC97-0310-C02-01

Fecha de inicio-fin: 01/12/1997 - 30/11/2000
Entidad/es participante/s: Centro de Investigación y Desarrollo de La Armada; Universidad Politécnica de Madrid (Coordinador)
Cuantía total: 76.314 €

29 **Nombre del proyecto:** Tecnologías de dispositivos optoelectrónicos para sistemas de telecomunicación: Tecnología de fabricación de diodos láser de alta eficiencia en banda 0,9 - 1,3 micras
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): José Luis Sánchez Rojas
Entidad/es financiadora/s:
Comunidad de Madrid. CAM 07T/0006/1997

Fecha de inicio-fin: 25/11/1997 - 24/11/1999
Cuantía total: 124.890 €

30 **Nombre del proyecto:** Optoelectronics Based on Si/SiGe Heterostructures
Entidad de realización: University of California at Los Angeles
Ciudad entidad realización: Los Angeles, Estados Unidos de América
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Kang L. Wang

Entidad/es financiadora/s:
Air Force Office of Scientific Research

Fecha de inicio-fin: 15/07/1991 - 31/05/1993

31 **Nombre del proyecto:** Properties and Device Applications of Si Based Superlattices
Entidad de realización: University of California at Los Angeles
Ciudad entidad realización: Los Angeles, Estados Unidos de América
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Kang L. Wang
Entidad/es financiadora/s:
Semiconductor Research Corporation **Tipo de entidad:** Asociaciones y Agrupaciones
Ciudad entidad financiadora: Estados Unidos de América

Fecha de inicio-fin: 01/06/1991 - 31/05/1993

32 **Nombre del proyecto:** Laseres Sintonizables de Estado Sólido
Entidad de realización: Universidad Autónoma de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Francisco Jaque Rechea
Entidad/es financiadora/s:
CAICYT. Ministerio de Educación y Ciencia

Fecha de inicio-fin: 01/11/1987 - 31/10/1989

33 **Nombre del proyecto:** Desarrollo e Investigación de Metales Sintéticos y Aleaciones Poliméricas
Entidad de realización: Instituto de Estructura de la Materia (CSIC)
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Francisco José Baltá Calleja
Entidad/es financiadora/s:
CAICYT. Ministerio de Educación y Ciencia

Fecha de inicio-fin: 01/12/1985 - 01/12/1987

Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas

1 **Nombre del proyecto:** DEVELOPMENT OF TRANSMITTERS FOR DIFFERENTIAL ABSORPTION LIDAR SYSTEMS BASED ON PHOTONIC INTEGRATED CIRCUITS
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Antonio Pérez Serrano
Entidad/es financiadora/s:
QLM TECHNOLOGY LTD **Tipo de entidad:** Entidad Empresarial

Fecha de inicio: 01/01/2023 **Duración:** 2 años

2 **Nombre del proyecto:** Desarrollo de un detector de IR bicolor de pozos cuánticos (Convenio UPM-CIDA P99 0920 182)
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid
Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): José Luis Sánchez Rojas
Entidad/es financiadora/s:

Centro de Investigación y Desarrollo de La Armada (CIDA)

Tipo de entidad: Organismo Público de Investigación

Fecha de inicio: 01/01/1999

Duración: 1 año

3 Nombre del proyecto: Superredes para fotodetectores de IR. Realización de un detector de IR bicolor II (Convenio UPM-CIDA P97 0920 411)

Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid

Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid

Tipo de entidad: Universidad

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): José Luis Sánchez Rojas

Entidad/es financiadora/s:

Centro de Investigación y Desarrollo de La Armada (CIDA)

Tipo de entidad: Organismo Público de Investigación

Fecha de inicio: 01/01/1998

Duración: 1 año

4 Nombre del proyecto: Superredes para fotodetectores de IR. Realización de un detector de IR bicolor I (Convenio UPM-CIDA P97 0920 282)

Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid

Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid

Tipo de entidad: Universidad

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): José Luis Sánchez Rojas

Entidad/es financiadora/s:

Centro de Investigación y Desarrollo de La Armada (CIDA)

Tipo de entidad: Organismo Público de Investigación

Fecha de inicio: 01/01/1997

Duración: 1 año

5 Nombre del proyecto: Desarrollo de un detector de IR basado en Superredes (Convenio UPM-CIDA P96 0920 225)

Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid

Entidad de realización: Universidad Politécnica de Madrid

Tipo de entidad: Universidad

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): José Luis Sánchez Rojas

Entidad/es financiadora/s:

Centro de Investigación y Desarrollo de La Armada (CIDA)

Tipo de entidad: Organismo Público de Investigación

Fecha de inicio: 01/01/1996

Duración: 1 año

Actividades científicas y tecnológicas

Producción científica

1 Índice H: 16
Fecha de aplicación: 05/10/2023
Fuente de Indice H: WOS

2 Índice H: 19
Fecha de aplicación: 05/09/2023
Fuente de Indice H: GOOGLE SCHOLAR

3 Índice H: 16
Fecha de aplicación: 05/09/2023
Fuente de Indice H: SCOPUS

Publicaciones, documentos científicos y técnicos

1 Pablo López-Querol; Clara Quevedo-Galan; Antonio Perez-Serrano; José Manuel G. Tijero; Ignacio Esquivias. Generation of optical frequency combs by Q-switching integrated multi-section semiconductor lasers. Optics Express. 31 - 20/25, pp. 33475 - 33485. 2023. Disponible en Internet en: <https://doi.org/10.1364/OE.498426>.
Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Autor de correspondencia: No
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - OPTICS (2022)
Índice de impacto: 3.8
Revista dentro del 25%: Si
Posición de publicación: 30
Num. revistas en cat.: 100

2 Alejandro Rosado; María R. Fernández-Ruiz; Pedro Corredera; José Manuel G. Tijero; Ignacio Esquivias. High-density and broad band optical frequency combs generated by pseudo-random phase modulation of optically injected gain-switched semiconductor lasers. Optics and Laser Technology. 163 - 109312, pp. 1 - 6. 2023. Disponible en Internet en: <https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2023.109312>.
Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Autor de correspondencia: No
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - OPTICS (2022)
Índice de impacto: 5
Revista dentro del 25%: Si
Posición de publicación: 18
Num. revistas en cat.: 100

3 A. Perez-Serrano; C. Quevedo-Galan; V.R. Aguilera-Sanchez; J.M.G. Tijero; I. Esquivias. Differential Absorption Lidar Transmitter Based on an Indium Phosphide Photonic Integrated Circuit for Carbon Dioxide Sensing. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. 28 - 5, pp. 1 - 8. 2022. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1109/JSTQE.2022.3156183>.
Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - OPTICS (2021)
Índice de impacto: 4.653
Revista dentro del 25%: Si

4 C. Quevedo-Galan; A. Perez-Serrano; I.E. Lopez-Delgado; J.M.G. Tijero; I. Esquivias. Dual-Comb Spectrometer Based on Gain-Switched Semiconductor Lasers and a Low-Cost Software-Defined Radio. IEEE Access. 9, pp. 92367 - 92373. 2021. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3091872>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Índice de impacto: 3.476
Revista dentro del 25%: No

5 C. Quevedo-Galán; V. Durán; A. Rosado; A. Pérez-Serrano; J.M.G. Tijero; I. Esquivias. Gain-switched semiconductor lasers with pulsed excitation and optical injection for dual-comb spectroscopy. Optics Express. 28 - 22, pp. 33307 - 33317. 2020. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1364/OE.404398>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - OPTICS
Índice de impacto: 3.894
Revista dentro del 25%: Si

6 A. Quirce; A. Rosado; J. Diez; A. Valle; A. Perez-Serrano; J.-M.G. Tijero; L. Pesquera; I. Esquivias. Nonlinear Dynamics Induced by Optical Injection in Optical Frequency Combs Generated by Gain-Switching of Laser Diodes. IEEE Photonics Journal. 12 - 4, pp. 1503314. 2020. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1109/JPHOT.2020.3009450>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - OPTICS
Índice de impacto: 2.443
Revista dentro del 25%: No

7 A. Rosado; E.P. Martin; A. Pérez-Serrano; J.M.G. Tijero; I. Esquivias; P.M. Anandarajah. Optical frequency comb generation via pulsed gain-switching in externally-injected semiconductor lasers using step-recovery diodes. Optics and Laser Technology. 131, pp. 106392. 2020. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.optlastec.2020.106392>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - OPTICS
Índice de impacto: 3.867
Revista dentro del 25%: Si

8 A. Rosado; A. Pérez-Serrano; J.M.G. Tijero; Á. Valle; L. Pesquera; I. Esquivias. Enhanced optical frequency comb generation by pulsed gain-switching of optically injected semiconductor lasers. Optics Express. 27 - 6, pp. 9155 - 9163. 2019. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1364/OE.27.009155>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - OPTICS
Índice de impacto: 3.669
Revista dentro del 25%: Si

9 A. Perez-Serrano; J.M.G. Tijero; S. Balle; I. Esquivias. Numerical Analysis of the Modulation Dynamics in an Integrated Three-Section MOPA Using a Voltage Driven Traveling-Wave Model. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. 25 - 6, 2019. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1109/JSTQE.2019.2913037>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - OPTICS
Índice de impacto: 4.917
Revista dentro del 25%: Si

10 A. Rosado; A. Perez-Serrano; J.M.G. Tijero; A.V. Gutierrez; L. Pesquera; I. Esquivias. Numerical and Experimental Analysis of Optical Frequency Comb Generation in Gain-Switched Semiconductor Lasers. IEEE Journal of Quantum Electronics. 55 - 6, pp. 2001012. 2019. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1109/JQE.2019.2943482>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Índice de impacto: 2.384
Revista dentro del 25%: No

11 A. Perez-Serrano; M. Vilera; J.M.G. Tijero; S. Balle; I. Esquivias. A Voltage Driven Traveling-Wave Model for the Simulation of an Integrated Three-Section MOPA under Static and Modulated Operation. IEEE Journal of Quantum Electronics. 54 - 2, pp. 1100210. 2018. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1109/JQE.2018.2797888>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - OPTICS
Índice de impacto: 2.753
Revista dentro del 25%: No

12 A. Rosado; A. Pérez-Serrano; J.M.G. Tijero; Á. Valle; L. Pesquera; I. Esquivias. Experimental study of optical frequency comb generation in gain-switched semiconductor lasers. Optics and Laser Technology. 108, pp. 542-550. 2018. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.optlastec.2018.07.038>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - OPTICS
Índice de impacto: 3.319
Revista dentro del 25%: Si

13 M. Quatrevalet; X. Ai; A. Perez-Serrano; P. Adamiec; J. Barbero; A. Fix; J.M.G. Tijero; I. Esquivias; J.G. Rarity; G. Ehret. Atmospheric CO-2 Sensing with a Random Modulation Continuous Wave Integrated Path Differential Absorption Lidar. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. 23 - 2, pp. 157 - 167. 2017. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1109/JSTQE.2016.2619325>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Índice de impacto: 3.971
Revista dentro del 25%: Si

14 M. Vilera; A. Pérez-Serrano; M. Faugeron; J.M.G. Tijero; M. Krakowski; F. Van Dijk; I. Esquivias. Modulation Performance of Three-Section Integrated MOPAs for Pseudorandom Lidar. IEEE Photonics Technology Letters. 29 - 17, pp. 1486 - 1489. 2017. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1109/LPT.2017.2730921>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Índice de impacto: 2.446
Revista dentro del 25%: No

15 J.M.G. Tijero; L. Borruel; M. Vilera; A. Perez-Serrano; I. Esquivias. Analysis of the performance of tapered semiconductor optical amplifiers: role of the taper angle. Optical and Quantum Electronics. 47 - 6, pp. 1437 - 1442. 2015. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1007/s11082-014-0108-8>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Índice de impacto: 1.29
Revista dentro del 25%: No

16 M. Vilera; A. Pérez-Serrano; J.M.G. Tijero; I. Esquivias. Emission Characteristics of a 1.5-µm All-Semiconductor Tapered Master Oscillator Power Amplifier. IEEE Photonics Journal. 7 - 2, 2015. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1109/JPHOT.2015.2402597>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Índice de impacto: 2.177
Revista dentro del 25%: Si

17 M. Faugeron; M. Vilera; M. Krakowski; Y. Robert; E. Vinet; P. Primiani; J.-P. Le Goëc; O. Parillaud; A. Pérez-Serrano; J.M.G. Tijero; G. Kochem; M. Traub; I. Esquivias; F. Van Dijk. High power three-section integrated master oscillator power amplifier at 1.5 µm. IEEE Photonics Technology Letters. 27 - 13, pp. 1449 - 1452. 2015. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1109/LPT.2015.2425534>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - OPTICS
Índice de impacto: 1.945
Revista dentro del 25%: No

18 A. Perez-Serrano; M. Vilera; J. Javaloyes; J.M.G. Tijero; I. Esquivias; S. Balle. Wavelength Jumps and Multimode Instabilities in Integrated Master Oscillator Power Amplifiers at 1.5µ: Experiments and Theory. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. 21 - 6, pp. 315 - 323. 2015. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1109/JSTQE.2015.2413408>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Índice de impacto: 3.466
Revista dentro del 25%: Si

19 P. Adamiec; J.M.G. Tijero; I. Esquivias. Analysis of gain-switching in two-section tapered lasers. Acta Physica Polonica A. 124 - 5, pp. 888 - 890. 2013. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.124.888>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY
Índice de impacto: 0.604
Revista dentro del 25%: No

20 P. Adamiec; A. Consoli; J.M.G. Tijero; S. Aguilera; I. Esquivias; S. Schwertfeger; A. Klehr; H. Wenzel; B. Sumpf; G. Erbert. High data rate modulation of high power 1060-nm DBR tapered lasers with separate contacts. IEEE Photonics Technology Letters. 25 - 22, pp. 2171 - 2173. 2013. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1109/LPT.2013.2283198>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - OPTICS
Índice de impacto: 2.176
Revista dentro del 25%: Si

21 P. Adamiec; B. Bonilla; A. Consoli; J.M.G. Tijero; S. Aguilera; I. Esquivias. High-peak-power pulse generation from a monolithic master oscillator power amplifier at 1.5 µm. Applied Optics. 51 - 30, pp. 7160 - 7164. 2012. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1364/AO.51.007160>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - OPTICS
Índice de impacto: 1.689
Revista dentro del 25%: No

22 A. Consoli; B. Bonilla; J.M.G. Tijero; I. Esquivias. Self-validating technique for the measurement of the linewidth enhancement factor in semiconductor lasers. Optics Express. 20 - 5, pp. 4979 - 4987. 2012. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1364/OE.20.004979>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - OPTICS
Índice de impacto: 3.544
Revista dentro del 25%: Si

23 A. Consoli; J.M.G. Tijero; I. Esquivias. Time resolved chirp measurements of gain switched semiconductor laser using a polarization based optical differentiator. Optics Express. 19 - 11, pp. 10805 - 10812. 2011. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1364/OE.19.010805>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - OPTICS
Índice de impacto: 3.587
Revista dentro del 25%: Si

24 R. Pagano; M. Ziegler; J.W. Tomm; I. Esquivias; J.M.G. Tijero; J.R. O'Callaghan; N. Michel; M. Krakowski; B. Corbett. Two-dimensional carrier density distribution inside a high power tapered laser diode. Applied Physics Letters. 98 - 22, pp. 221110. 2011. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1063/1.3596445>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - PHYSICS, APPLIED
Índice de impacto: 3.844
Revista dentro del 25%: Si

25 H. Odriozola; J.M.G. Tijero; L. Borruel; I. Esquivias; H. Wenzel; F. Dittmar; K. Paschke; B. Sumpf; G. Erbert. Beam properties of 980-nm tapered lasers with separate contacts: Experiments and simulations. IEEE Journal of Quantum Electronics. 45 - 1, pp. 42 - 50. 2009. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1109/JQE.2008.2005358>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Índice de impacto: 1.968
Revista dentro del 25%: Si

26 N. Michel; H. Odriozola; C.H. Kwok; M. Ruiz; M. Calligaro; M. Lecomte; O. Parillaud; M. Krakowski; M. Xia; R.V. Penty; I.H. White; J.M.G. Tijero; I. Esquivias. High modulation efficiency and high power 1060nm tapered lasers with separate contacts. Electronics Letters. 45 - 2, pp. 103 - 105. 2009. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1049/el:20093298>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Índice de impacto: 0.97
Revista dentro del 25%: No

27 H. Odriozola; J.M.G. Tijero; I. Esquivias; L. Borruel; A. Martín-Mínguez; N. Michel; M. Calligaro; M. Lecomte; O. Parillaud; M. Ruiz; M. Krakowski. Design of 1060nm tapered lasers with separate contacts. Optical and Quantum Electronics. 40, pp. 1123 - 1127. 2008. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1007/s11082-009-9270-9>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - OPTICS
Índice de impacto: 0.657
Revista dentro del 25%: No

28 L. Borruel; H. Odriozola; J.M.G. Tijero; I. Esquivias; S. Sujecki; E.C. Larkins. Design strategies to increase the brightness of gain guided tapered lasers. Optical and Quantum Electronics. 40 - 2-4, pp. 175 - 189. 2008. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1007/s11082-008-9187-8>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - OPTICS
Índice de impacto: 0.761
Revista dentro del 25%: No

29 J.M.G. Tijero; H. Odriozola; L. Borruel; I. Esquivias; S. Sujecki; E.C. Larkins. Enhanced brightness of tapered laser diodes based on an asymmetric epitaxial design. IEEE Photonics Technology Letters. 19 - 20, pp. 1640 - 1642. 2007. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1109/LPT.2007.905083>.
Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - OPTICS
Índice de impacto: 2.015
Revista dentro del 25%: Si

30 J.M. Ulloa; J.L. Sánchez-Rojas; A. Hierro; J.M.G. Tijero; E. Tournié. Effect of Nitrogen on the Band Structure and Material Gain of In <inf>y</inf>Ga<inf>1-y</inf>As<inf>1-x</inf>N<inf>x</inf>-GaAs Quantum Wells. IEEE Journal on Selected Topics in Quantum Electronics. 9 - 3, pp. 716 - 722. 2003. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1109/JSTQE.2003.818860>.
Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Índice de impacto: 2.709
Revista dentro del 25%: Si

31 E. Luna; A. Guzmán; J.L. Sánchez-Rojas; J.M.G. Tijero; R. Hey; J. Hernando; E. Muñoz. Growth and characterization of modulation-doped double barrier quantum well infrared photodetectors. Journal of Vacuum Science and Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures. 21 - 2, pp. 883 - 887. 2003. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1116/1.1562643>.
Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - PHYSICS, APPLIED
Índice de impacto: 1.6
Revista dentro del 25%: Si

32 E. Luna; J.L. Sánchez-Rojas; A. Guzmán; J.M.G. Tijero; E. Muñoz. Modulation-doped double-barrier quantum well infrared detectors for photovoltaic operation in 3-5 µm. IEEE Photonics Technology Letters. 15 - 1, pp. 105 - 107. 2003. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1109/LPT.2002.805791>.
Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Índice de impacto: 2.258
Revista dentro del 25%: Si

33 J.J. Sánchez; J.I. Izpura; J.M.G. Tijero; E. Muñoz; S. Cho; A. Majerfeld. Confirmation of the pyroelectric coefficient of strained In <inf>x</inf>Ga <inf>1-x</inf>As/GaAs quantum well structures grown on (111)B GaAs by differential photocurrent spectroscopy. Journal of Applied Physics. 91 - 5, pp. 3002 - 3006. 2002. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1063/1.1445278>.
Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - PHYSICS, APPLIED
Índice de impacto: 2.281
Revista dentro del 25%: Si

34 S. Cho; A. Majerfeld; J.J. Sánchez; E. Muñoz; J.M.G. Tijero; J.I. Izpura. Observation of the pyroelectric effect in strained piezoelectric InGaAs/GaAs quantum-wells grown on (111) GaAs substrates. Microelectronics Journal. 33 - 7, pp. 531 - 534. 2002. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1016/S0026-2692(02)00014-9>.
Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)

Categoría: Science Edition - ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Índice de impacto: 0.457 **Revista dentro del 25%:** No

35 J.M. Ulloa; L. Borruel; J.M.G. Tijero; J. Temmyo; I. Esquivias; I. Izpura; J.L. Sánchez-Rojas. Spontaneous emission study of (111) InGaAs/GaAs quantum well lasers. Microelectronics Journal. 33 - 7, pp. 589 - 593. 2002. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1016/S0026-2692(02)00024-1>.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR) **Categoría:** Science Edition - ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Índice de impacto: 0.457 **Revista dentro del 25%:** No

36 J. Hernando; J.M.G. Tijero; J.L. Sánchez De Rojas. Temperature control in InGaAs-based quantum well structures grown by molecular beam epitaxy on GaAs (1 0 0) and GaAs (1 1 1)B substrates. Journal of Crystal Growth. 246 - 1-2, pp. 1 - 8. 2002. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1016/S0022-0248(02)01703-7>.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR) **Categoría:** Science Edition - CRYSTALLOGRAPHY
Índice de impacto: 1.529 **Revista dentro del 25%:** No

37 J. Hernando; J.L. Sánchez-Rojas; A. Guzmán; E. Muñoz; J.M.G. Tijero; D. González; G. Aragón; R. García. Effect of indium content on the normal-incident photoresponse of InGaAs/GaAs quantum-well infrared photodetectors. Applied Physics Letters. 78 - 16, pp. 2390 - 2392. 2001. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1063/1.1365951>.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR) **Categoría:** Science Edition - PHYSICS, APPLIED
Índice de impacto: 3.849 **Revista dentro del 25%:** Si

38 A. Guzman; J.L. Sanchez-Rojas; J.M.G. Tijero; J.J. Sanchez; J. Hernando; E. Calleja; E. Muñoz; G. Vergara; M. T. Montojo; J. L. Gomez; P. Rodriguez; R. Almazan; M. Verdu. Optical characterization of quantum well infra-red detector structures. IEE PROCEEDINGS-OPTOELECTRONICS. 146, pp. 10 - 14. 2001. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1049/ip-opt:19990183>.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR) **Categoría:** Science Edition - TELECOMMUNICATIONS
Índice de impacto: 0.826 **Revista dentro del 25%:** Si

39 A. Guzmán; J.L. Sánchez-Rojas; J.M.G. Tijero; J. Hernando; E. Calleja; E. Muñoz; G. Vergara; R. Almazán; F.J. Sánchez; M. Verdú; M.T. Montojo. Voltage-tunable two-colour quantum well infrared detector with Al-graded triangular confinement barriers. Semiconductor Science and Technology. 16 - 5, pp. 285 - 288. 2001. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1088/0268-1242/16/5/301>.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR) **Categoría:** Science Edition - ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Índice de impacto: 1.079 **Revista dentro del 25%:** Si

40 A. Guzmán; J.L. Sánchez-Rojas; J.M.G. Tijero; J. Hernando; E. Calleja; E. Muñoz; G. Vergara; R. Almazán; L.J. Gómez; M. Verdú; M.T. Montojo. Growth and characterization of a bound-to-quasi-continuum QWIP with Al-graded triangular confinement barriers. IEEE Photonics Technology Letters. 11 - 12, pp. 1650 - 1652. 1999. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1109/68.806876>.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista

Fuente de impacto: WOS (JCR) **Categoría:** Science Edition - PHYSICS, APPLIED
Índice de impacto: 2.136 **Revista dentro del 25%:** Si

41 J.J. Sánchez; M. Gutiérrez; D. González; G. Aragón; J.M.G. Tijero; J.L. Sánchez-Rojas; I. Izpura; R. García. Influence of substrate misorientation on the optical and structural properties of InGaAs/GaAs single strained quantum wells grown on (111)B GaAs by molecular beam epitaxy. Microelectronics Journal. 30 - 4, pp. 373 - 378. 1999. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1016/S0026-2692(98)00138-4>.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR) **Categoría:** Science Edition - ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Índice de impacto: 0.363 **Revista dentro del 25%:** No

42 J.J. Sánchez; J.M.G. Tijero; J. Hernando; J.L. Sánchez-Rojas; I. Izpura. Optical investigation of the relaxation process in InGaAs/GaAs single strained quantum wells grown on (001) and (111)B GaAs substrates. Microelectronics Journal. 30 - 4, pp. 363 - 366. 1999. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1016/S0026-2692(98)00136-0>.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR) **Categoría:** Science Edition - ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Índice de impacto: 0.363 **Revista dentro del 25%:** No

43 J.J. Sánchez; J.M.G. Tijero; I. Izpura; J.L. Sánchez-Rojas; M. Hopkinson; M. Gutiérrez; D. González; G. Aragón; R. García. Relaxation study of In<inf>x</inf>Ga<inf>1-x</inf>As/GaAs quantum-well structures grown by MBE on (0 0 1) and (1 1 1)B GaAs for long wavelength applications. Journal of Crystal Growth. 206 - 4, pp. 287 - 293. 1999. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1016/S0022-0248(99)00324-3>.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR) **Categoría:** Science Edition - CRYSTALLOGRAPHY
Índice de impacto: 1.492 **Revista dentro del 25%:** No

44 J.J. Sánchez; O. Marty; M. Hopkinson; I. Izpura; A. Guzmán; J.M.G. Tijero. Structural and morphological characteristics of InGaAs/GaAs quantum well structures on tilted (1 1 1)B GaAs grown by MBE. Journal of Crystal Growth. 192 - 3-4, pp. 363 - 371. 1998. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1016/S0022-0248(98)00471-0>.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR) **Categoría:** Science Edition - CRYSTALLOGRAPHY
Índice de impacto: 1.307 **Revista dentro del 25%:** No

45 F. Calle; F.J. Sánchez; J.M.G. Tijero; M.A. Sánchez-García; E. Calleja; R. Beresford. Exciton and donor-acceptor recombination in undoped GaN on Si(111). Semiconductor Science and Technology. 12 - 11, pp. 1396 - 1403. 1997. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1088/0268-1242/12/11/011>.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR) **Categoría:** Science Edition - ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Índice de impacto: 1.141 **Revista dentro del 25%:** Si

46 E. Calleja; F. Sánchez; D. Basak; M. Sánchez-García; E. Muñoz; I. Izpura; F. Calle; J. Tijero; J. Sánchez-Rojas; B. Beaumont; P. Lorenzini; P. Gibart. Yellow luminescence and related deep states in undoped GaN. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. 55 - 7, pp. 4689 - 4694. 1997. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.55.4689>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - PHYSICS, CONDENSED MATTER
Índice de impacto: 2.88
Revista dentro del 25%: Si

47 F.J. Sánchez; F. Calle; D. Basak; J.M.G. Tijero; M.A. Sánchez-García; E. Monroy; E. Calleja; E. Muñoz; B. Beaumont; P. Gibart; J.J. Serrano; J.M. Blanco. Yellow luminescence in Mg-doped GaN. MRS Internet Journal of Nitride Semiconductor Research. 2, pp. 1 - 7. 1997. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1557/s109257830000154x>.
Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY
Índice de impacto: 2.099
Revista dentro del 25%: Si

48 F.J. Sánchez; D. Basak; M.A. Sánchez-Garcia; E. Calleja; E. Muñoz; I. Izpura; F. Calle; J.M.G. Tijero; B. Beaumont; P. Lorenzini; P. Gibart; T.S. Cheng; C.T. Foxon; J.W. Orton. Yellow band and deep levels in undoped MOVPE GaN. MRS Internet Journal of Nitride Semiconductor Research. 1, pp. 1 - 5. 1996. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1557/s1092578300001794>.
Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY
Índice de impacto: 2.099
Revista dentro del 25%: Si

49 M. Esteban; M. Garay; J.M. García-Tijero; E. Verdasco; A.G. Ureña. Influence of the radical size on the Ca[*] + ROH → CaOH[*] + R (RCH<inf>3</inf>, C<inf>2</inf>H<inf>5</inf> and C<inf>3</inf>H<inf>7</inf>) reaction cross section. Chemical Physics Letters. 230 - 6, pp. 525 - 529. 1994. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(94)01181-8>.
Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL
Índice de impacto: 2.614
Revista dentro del 25%: Si

50 J.M.G. Tijero; V. Arbet-Engels; A. Manissadjian; K.L. Wang; V. Higgs. Effect of hydrogenation on the luminescence of strained Si <inf>1-x</inf>Ge<inf>x</inf> alloy layers grown by molecular beam epitaxy. Journal of Applied Physics. 74 - 2, pp. 1279 - 1282. 1993. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1063/1.354932>.
Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - PHYSICS, APPLIED
Índice de impacto: 1.784
Revista dentro del 25%: Si

51 V. Arbet-Engels; J.M.G. Tijero; A. Manissadjian; K.L. Wang; V. Higgs. Investigation of the growth technique dependence on the optical properties of Si<inf>1-x</inf>Ge<inf>x</inf> alloy layers. Journal of Crystal Growth. 127 - 1-4, pp. 406 - 410. 1993. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1016/0022-0248(93)90649-H>.
Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - CRYSTALLOGRAPHY
Índice de impacto: 1.648
Revista dentro del 25%: Si

52 J.M.G. Tijero; A. Ibarra. Use of luminescence of Mn²⁺ and Cr³⁺ in probing the disordering process in MgAl<inf>2</inf>O<inf>4</inf> spinels. Journal of Physics and Chemistry of Solids. 54 - 2, pp. 203 - 207. 1993. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1016/0022-3697(93)90309-F>.

Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Condensed Matter Physics
Índice de impacto: 1.437
Revista dentro del 25%: No

53 V. Arbet-Engels; J.M.G. Tijero; A. Manissadjian; K.L. Wang; V. Higgs. Luminescence of strained Si<inf>1-x</inf>Ge<inf>x</inf> alloy layers grown by molecular beam epitaxy. Applied Physics Letters. 61 - 21, pp. 2586 - 2588. 1992. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1063/1.108135>.
Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - PHYSICS, APPLIED
Índice de impacto: 3.537
Revista dentro del 25%: Si

54 C. H. Chern; J.M.G. Tijero; K.L. Wang; S. J. Wang. Magnetotunneling of GeSi Resonant Tunneling Structures Grown at Extremely Low Temperature by MBE. J. Vac. Sci. Tech. B. 10, pp. 937 - 939. 1992. Disponible en Internet en: <http://dx.10.1116/1.586093>.
Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Science Edition - PHYSICS, APPLIED
Índice de impacto: 2.27
Revista dentro del 25%: Si

55 J.M.G. Tijero; F. Jaque. Thermal and optical properties of the FA and (F2+)A centers in Na-doped CaF2 crystals. Physical Review B. 41 - 6, pp. 3832 - 3836. 1990. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.41.3832>.
Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Condensed Matter Physics
Índice de impacto: 3.62
Revista dentro del 25%: Si

56 J.M. Garcia Tijero; J. Casas-Gonzalez; F. Jaque. F<inf>2A</inf> centres formation in CaF<inf>2</inf>:Na⁺. Journal of Luminescence. 40-41 - C, pp. 109 - 110. 1988. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1016/0022-2313(88)90111-1>.
Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: OPTICS
Índice de impacto: 1.389
Revista dentro del 25%: Si

57 J. Martinez Salazar; J.M. Garcia Tijero; F.J. Balta Calleja. Microstructural changes in polyethylene-polypropylene blends as revealed by microhardness. Journal of Materials Science. 23 - 3, pp. 862 - 866. 1988. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1007/BF01153980>.
Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Materials Science
Índice de impacto: 0.781
Revista dentro del 25%: Si

58 J.M.G. Tijero; J. Casas-Gonzalez. ON THE COLORATION PROPERTIES OF CaF<inf>2</inf>: Na.Journal de physique. Lettres. 46 - 18, pp. 861 - 868. 1985. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1051/jphyslet:019850046018086100>.
Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR)
Categoría: Physics
Índice de impacto: 2.732
Revista dentro del 25%: Si

59 I. Esquivias; A. Pérez-Serrano; J.-M.G. Tijero. High-brightness tapered lasers. Handbook of Optoelectronic Device Modeling and Simulation: Lasers, Modulators, Photodetectors, Solar Cells, and Numerical Methods. 2, pp. 59 - 80. CRC Press, 2017. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.4324/9781315152318>. ISBN 9781498749565
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
Fuente de impacto: WOS (JCR)

60 J.-M.G. Tijero; A. Pérez-Serrano; G. del Pozo; I. Esquivias. Tapered semiconductor optical amplifiers. Handbook of Optoelectronic Device Modeling and Simulation: Fundamentals, Materials, Nanostructures, LEDs, and Amplifiers. 1, pp. 697 - 714. 2017. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.1201/9781315152301>. ISBN 9781498749466
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
Fuente de impacto: WOS (JCR)

Otros méritos

Estancias en centros de I+D+i públicos o privados

1 **Entidad de realización:** Universite de Paris VI
Facultad, instituto, centro: Groupe de Physique des Solids (GPS)
Ciudad entidad realización: Paris, Francia
Fecha de inicio-fin: 10/04/1994 - 10/10/1994
Entidad financiadora: Commission of the European Communities
Nombre del programa: Human Capital and Mobility (HCM)
Objetivos de la estancia: Posdoctoral

2 **Entidad de realización:** University of California at Los Angeles (UCLA)
Facultad, instituto, centro: Electrical Engineering Department
Ciudad entidad realización: Los Angeles,
Fecha de inicio-fin: 01/07/1992 - 31/12/1992
Entidad financiadora: Air Force Office of Scientific Research (AFOSR)
Ciudad entidad financiadora: Estados Unidos de América
Nombre del programa: Optoelectronics Based on Si/SiGe Heterostructures
Objetivos de la estancia: Contratado/a

3 **Entidad de realización:** University of California at Los Angeles (UCLA)
Facultad, instituto, centro: Electrical Engineering Department
Ciudad entidad realización: Los Angeles, Estados Unidos de América
Fecha de inicio-fin: 12/12/1990 - 30/06/1992
Entidad financiadora: OTAN
Nombre del programa: Beca Posdoctoral OTAN
Objetivos de la estancia: Posdoctoral

Períodos de actividad investigadora

Nº de tramos reconocidos:
Ámbito geográfico: Nacional
Entidad acreditante: CNEAI
Fecha de obtención: 05/05/2023